

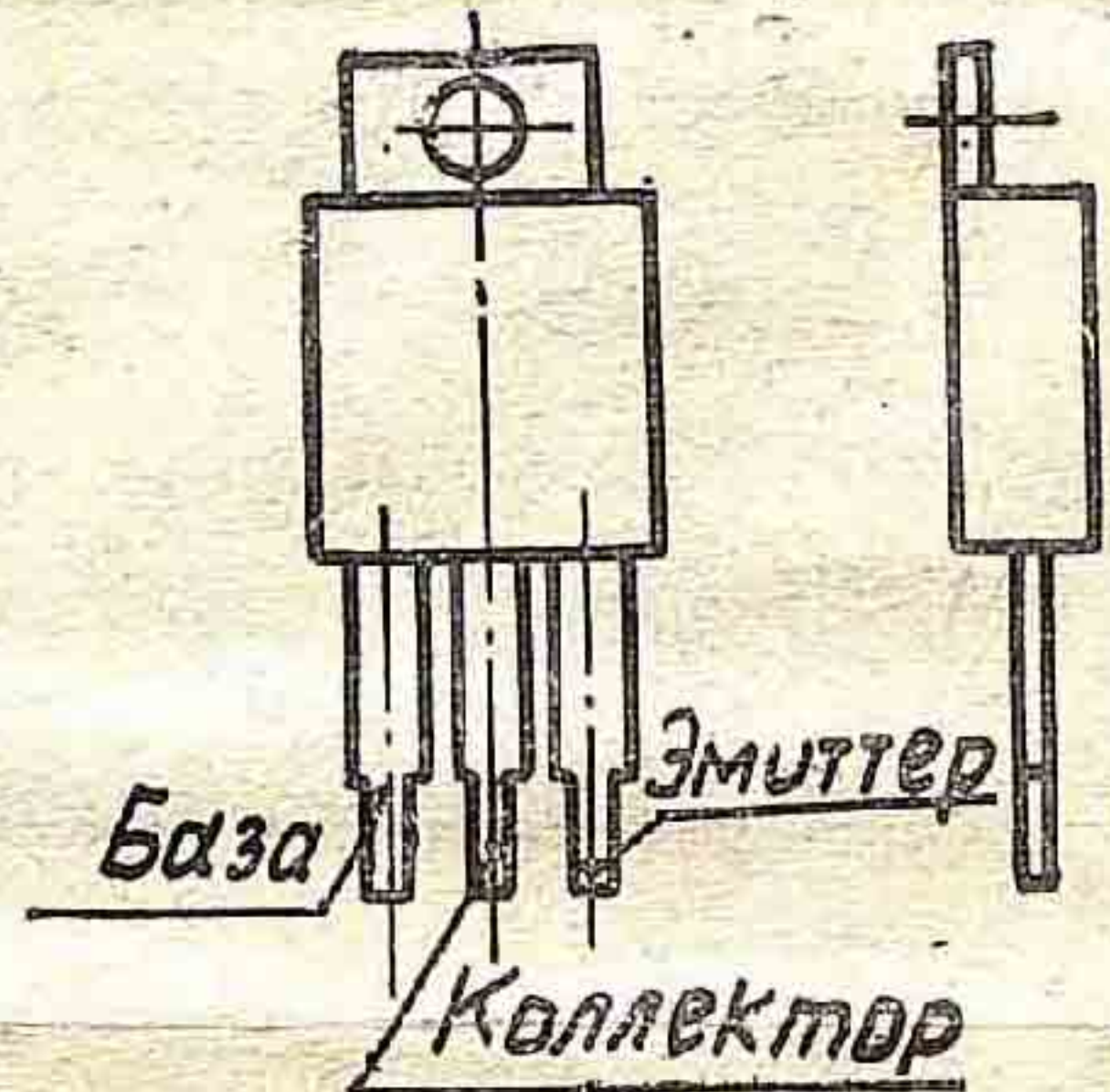


## ЭТИКЕТКА

Кремниевые меза-планарные составные п-р-п мощные транзисторы КТ829А, КТ829Б, КТ829В, КТ829Г, КТ829Д в пластмассовом корпусе предназначены для работы в усилителях низкой частоты, ключевых схемах.

Вид климатического исполнения УХЛ 3.1, 5.1.

Корпус типа КТ-28-2 по ГОСТ 18472-88



Масса транзистора не более 3 г

Таблица 1

Основные электрические параметры при  $T_{\text{корп.}} = (25 \pm 10)^\circ\text{C}$

Наименование параметра, единица измерения, режим измерения	Буквенное обозначен.	Норма	
		не менее	не более
Статический коэффициент передачи тока $U_{кэ} = 3 \text{ В}$ , $I_{к} = 3 \text{ А}$	$h_{21э}$	750	—
Обратный ток коллектора, мА $U_{кб} = 100 \text{ В}$ для КТ829А $U_{кб} = 80 \text{ В}$ для КТ829Б $U_{кб} = 60 \text{ В}$ для КТ829В $U_{кб} = 45 \text{ В}$ для КТ829Г $U_{кб} = 200 \text{ В}$ для КТ829Д	$I_{кбо}$	—	0,2
		—	0,2
		—	0,2
		—	0,2
		—	0,2
Обратный ток эмиттера, мА $U_{эб} = 5 \text{ В}$ , $I_{к} = 0$	$I_{эбо}$	—	2
Граничное напряжение, В для КТ829А $L = 40 \text{ мГн}$ для КТ829Б для КТ829В $I_{к} = 0,1 \text{ А}$ для КТ829Г для КТ829Д		100	—
		80	—
		60	—
		45	—
		140	—
Напряжение насыщения коллектор-эмиттер, В $I_{к} = 3 \text{ А}$ $I_{б} = 0,012 \text{ А}$	$U_{кэ \text{ нас}}$	—	2

Напряжение насыщения база-эмиттер, В $I_k=3 \text{ A}, I_b=0,012 \text{ A}$	$U_{бэ \text{ нас}}$	—	2,5
Модуль коэффициента передачи тока на высокой частоте $U_{кэ}=3 \text{ В}, I_k=3 \text{ A}, f=10 \text{ МГц}$	$(h_{21э})$	0,4	—
Обратный ток коллектор-эмиттер, мА $U_{кэ}=50 \text{ В}$ для КТ829А $U_{кэ}=40 \text{ В}$ для КТ829Б $U_{кэ}=30 \text{ В}$ для КТ829В $U_{кэ}=22 \text{ В}$ для КТ829Г $U_{кэ}=70 \text{ В}$ для КТ829Д	$I_{кэо}$	—	0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

Содержание драгметаллов в 1000 транзисторов:

Серебра — 0,0850 г

Содержание цветных металлов и их сплавов в 1000 шт. транзисторов

Наименование цветного металла или сплава	Марка	Масса, г
Медь	МО6	1820

#### Сведения о приемке

Транзисторы КТ829А, КТ829Б, КТ829В, КТ829Г, КТ829Д  
соответствуют техническим условиям АА0.336.292ТУ

Штамп ОТК

#### Указания по эксплуатации

Указания по применению и эксплуатации транзисторов по ГОСТ 11630-84,  
ОСТ II 336.907.0-79.

Транзисторы необходимо применять с теплоотводами. Крепление транзисторов к теплоотводам должно обеспечивать надежный тепловой контакт. Для улучшения теплового контакта необходимо наносить на нижнее основание корпуса транзистора жидкость ПМС-100 по ГОСТ 13032-77 или другую теплопроводящую смазку.

При пайке выводов температура корпуса транзистора не должна превышать 85°C.

Допускается формовка выводов транзисторов в направлении, перпендикулярном плоскости его основания. Минимально допустимое расстояние от корпуса до места изгиба 3 мм.

Формовку проводить с обязательной фиксацией выводов. Место фиксации — между корпусом и местом изгиба.